

# КТ357А, КТ357Б, КТ357В, КТ357Г

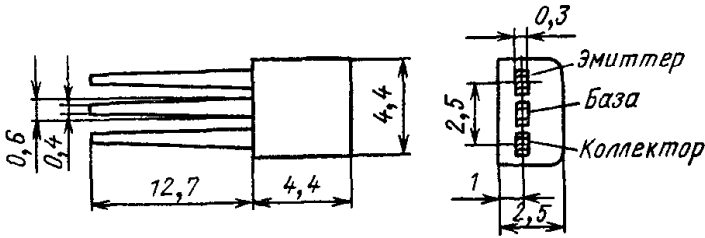
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* универсальные высокочастотные маломощные

Предназначены для работы в схемах переключения и усиления высокой частоты

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.

Обозначение типа приводится на этикетке

Масса транзистора не более 0,2 г



## Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более . . . . .	0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более . . . . .	1 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 0,5$ В, $I_K = 10$ мА	
при $T = 298$ К	
КТ357А, КТ357В . . . . .	20 – 100
КТ357Б, КТ357Г . . . . .	60 – 300
при $T = 358$ К	
КТ357А, КТ357В . . . . .	20 – 250
КТ357Б, КТ357Г . . . . .	60 – 750
при $T = 233$ К	
КТ357А, КТ357В . . . . .	8 – 100
КТ357Б, КТ357Г . . . . .	20 – 300
Модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $f = 100$ МГц, $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 10$ мА не менее . . . . .	
	3
Время рассасывания при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более . . . . .	150 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 5$ МГц не более . . . . .	7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 0$ В не более . . . . .	10 пФ

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)  
Энергоатомиздат, 1985

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ \text{ макс}}$ не более	
при $T = 298 \text{ К}$ и $T = 233 \text{ К}$ . . . . .	5 мкА
при $T = 358 \text{ К}$ . . . . .	40 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 3,5 \text{ В}$ не более	5 мкА

**Предельные эксплуатационные данные**

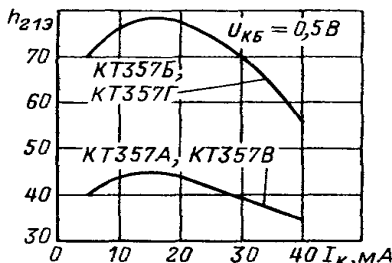
Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор-эмиттер	
КТ357А, КТ357Б . . . . .	6 В
КТ357В, КТ357Г . . . . .	20 В
Постоянное напряжение база-эмиттер . . . . .	3,5 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	40 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 1 \text{ мкс}$ , $P_{К, ср} \leq P_{К \text{ макс}}$ . . . . .	80 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 233 - 323 \text{ К}$ . . . . .	100 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $\tau_{и} \leq 1 \text{ мкс}$ . . . . .	200 мВт
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до 358К

Примечания 1 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при  $T = 323 - 358 \text{ К}$  рассчитывается по формуле

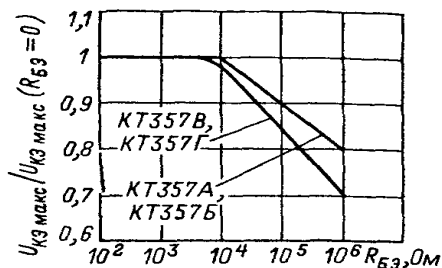
$$P_{К \text{ макс}} = 50 + (358 - T) / 0,7$$

2 Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора Пайка производится при температуре 533 К в течение 10 с Категорически запрещается кручение выводов вокруг оси Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами.

Допускается трехкратный изгиб выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 1 мм.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.

Материал взят из источника: